# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-193450

(43) Date of publication of application: 28.07.1995

(51)Int.CI.

HO3H 3/08 HO3H 9/145

(21)Application number: 05-332639

(71)Applicant:

KYOCERA CORP

(22)Date of filing:

27 12 1993

(72)Inventor:

ITO MIKI

# (54) SURFACE ACOUSTIC WAVE ELEMENT AND MANUFACTURE OF THE SAME

(57)Abstract:

PURPOSE: To easily manufacture high-reliability surface acoustic wave(SAW) elements by thickening the film of a pad for wire bonding without increasing the depositing process of a matel film

CONSTITUTION: A single resist layer 2 is formed by applying novolak resin resist to a tetrabolic lithium monocrystal transparent base plate 1. A resist pattern 3 is formed by covering this resist with an opening glass mask in a prescribed shape, and an aluminum thin film 4c, aluminum thin film 4a to be an interdigital electrode and aluminum thin film 4b of the pad for (b) wire bonding are attached and formed on it. The pattern 3 is dissolved away and while remaining the thin films 4a and 4b, the aluminum thin film 4c is peeled off as well. Then, single layers of (C) resist 5a, 5b and 5c are applied on it and covered with the glass mask and after the other resist is removed later while leaving only the resist 5b, the thin film 4a to be the interdigital electrode is etched to the set film thickness. Finally, the resist 5b is dissolved away, and an element S provided with the metal electrode pattern 4d of the desired interdigital electrode and the (9) pad 4b for wire bonding is produced.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

25.12.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application

converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3318418

[Date of registration]

14.06.2002

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平7-193450

(43)公開日 平成7年(1995)7月28日

(51) Int. C1.6

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

H03H 3/08 7259-5 J

9/145

D 7259-5 J

請求項の数2 未請求

OL

FΙ

(全4頁)

(21) 出願番号

特願平5-332639

(22) 出願日

平成5年(1993)12月27日

(71)出願人 000006633

京セラ株式会社

京都府京都市山科区東野北井ノ上町5番地

の22

(72) 発明者 伊藤 幹

滋賀県八日市市蛇溝町長谷野1166番地の6

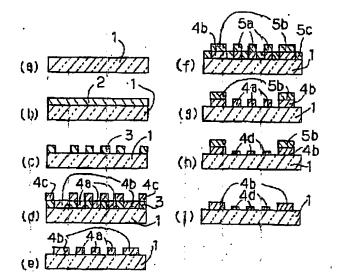
京セラ株式会社滋賀工場内

# (54) 【発明の名称】 弾性表面波素子及びその製造方法

## (57)【要約】

金属薄膜の被着工程を増やすことなく、ワイ ヤボンディング用パッドの膜厚のみを厚くする画期的な 弾性表面波案子の製造法を提供すること。

【構成】 弾性表面波素子Sの製造方法は、圧電体の基 板1上に金属電極4d及び該金属電極のワイヤボンディ ング用パッド4bを形成した弾性表面波素子Sの製造方 法であって、金属電極4dの設定膜厚より厚い金属膜を 基板1上にパターニング形成し、その後ワイヤボンディ ング用パッド4bとなるパターニング領域上にのみレジ ストを形成させた状態で金属膜のパターニング領域の表 面をエッチングして金属電極のパターニング領域4 dを 形成し、さらにレジストを除去することにより金属電極 のパターニング領域4dより厚いワイヤボンディング用 パッド4bを形成することを特徴とする。



1

## 【特許請求の範囲】

ι.

四ホウ酸リチウムの基板上に、アルミニ 【請求項』】 ウム又はその合金の単層から成る金属電極及び該金属電 極より厚いワイヤボンディング用パッドを形成したこと を特徴とする弾性表面波案子。

【請求項2】 圧電体の基板上に金属電極及びワイヤボ ンディンダ用パッドを形成する弾性表面波素子の製造方 法であって、前記金属電極及びワイヤボンディング用パ ッドが下記(1)~(3)の工程により形成されること を特徴とする弾性表面波索子の製造方法。

- (1) 圧電体の基板上に金属膜を被着させる工程.
- (2) 前記金属膜をフォトリソグラフィにより金属電極 領域とワイヤボンディング用パッドを形成する工程.
- (3) 前記ワイヤボンディング用パッドをレジストで被 覆した後、エッチングにより前記金鳳電極領域の金属膜 を薄くせしめ金属電極とする工程.

# 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は電極パターンを形成した 弾性表面披素子、及び特にリフトオフ工程による弾性表 20 面波素子の製造方法に関する。

## [0002]

【従来の技術】現在、TV・VTR・移動体通信等に応 用される弾性表面波を用いた高周波フィルタの主要部 は、例えば圧電体の基板、該基板上の櫛形電極、及びワ イヤボンディング用パッドで構成されている。従来より 基板材料として、ニオブ酸リチウム (LiNbO3) やタンタ ル酸リチウム (LiTaO3) 等の単結晶が広く用いられてい るが、これらの材料はフィルタの挿入損失や温度特性の 両方を十分満足するものではないため、最近では電気・ 機械結合定数が大きく、零温度係数を有する四ホウ酸リ チウム (Li2B407) 単結晶が注目されている。

【0003】ところが、Li2B407 単結晶は酸に侵されや すく、この単結晶を基板とする弾性表面波案子を用いた 髙周波フィルタを製造する際に、高周波フィルタの電極 を酸性のエッチング液によるパターニングで形成するこ とは不可能である。そこで、従来は酸を使用するケミカ ルエッチングを不要とするリフトオフ工程によりパター ニングを施す方法が提案されている(例えば、M. Hatzak is et. al, IBM J. RES. DEVELOP VOL. 24, NO. 4, JULY 1980 p 40 452 ~460 参照)。

【0004】一般に、櫛形電極及びワイヤボンディング 用パッドの材料としては、導電性の良好な材料が用いら れており、例えば、250MHz帯の髙周波フィルタで は、膜厚約0.2μmのアルミニウム薄膜が適当とされ ている。上記従来のリフトオフ工程では、基板上にレジ ストを被着形成し、これをパターニングして、パターニ ングしたレジスト上及び基板上にアルミニウム薄膜を被 着形成し、その後レジストを消失させて電極を形成する ものであるが、レジストをパターニングする際に形成し 50

たオーバハング形状の変形を防ぐために、アルミニウム 薄膜被着時に、基板を高温に加熱することができず、ア ルミニウム薄膜の基板に対する密着強度が低下しワイヤ ボンディングできないという問題がある。

【0005】上記の問題を解決するために、ワイヤボン ディング用パッド部のみをワイヤボンディングに耐える 膜厚(例えば250MHz帯の高周波フィルタでは、約 5~1 μm)のアルミニウム薄膜で補強するため に、アルミニウム薄膜を2層に重ねる方法が提案されて 10 いる (例えば特開平3-209909号公報)。

【0006】これは図2(a)~(i)に示す方法であ って、まず、洗浄した圧電体の基板11上に(図2 (a))、ワイヤボンドのボンダビリティを考慮して所 望厚さのボンディングパッド形成用のアルミニウム薄膜 12を真空蒸着により被着形成する(図2(b))。次. に、アルミニウム薄膜12の上にレジスト13を塗布形 成し(図2(c))、アルミニウム薄膜12及びレジス ト13をフォトエッチングによりパターニングして(図 2 (d)) 、レジスト13を除去してボンディングパッ ド14を形成する(図2(e))。次に、ボンディング パッド14及び基板11上に櫛形電極用アルミニウム薄 膜15を真空蒸着により被着形成する(図2(f))。----そして、図2 (c) ~;(e) と同様にして、レジスト1 6の塗布形成(図2(g)、フォトエッチングによるア ルミニウム薄膜15のパターニング(図2(h))、及 びレジスト16の除去により所望の櫛形電極17を形成 する (図2 (i))。

## [0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 来の方法では、例えば膜厚  $1 \mu$  m程度のワイヤボンディ ング用パッドを先に形成するが、この1μμの段差のた めに櫛形電極の微細加工における密着露光時の密着性が きわめて不均一となり、これにより素子特性を左右する 櫛形電極の直線性が悪くなる。さらに、アルミニウム薄 膜の被着形成工程が余分に必要となるといった問題点が あった。

【0008】そこで、本発明は上記従来の問題点を解決 するため、四ホウ酸リチウムを基板としアルミニウムを 金属電極とする新規な構成の弾性表面波素子、及び金属 薄膜の被着工程を増やすことなく、ワイヤボンディング 用パッドの膜厚のみを厚くする画期的な弾性表面波索子 の製造法を提供することを目的とする。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明の弾性表面波索子は、四ホウ酸リチウムの基 板上に、アルミニウム又はその合金の単層から成る、金 **鳳電極及び該金鳳電極より厚いワイヤボンディング用パ** ッドを形成したことを特徴とする。

【0010】また、その製造方法は、金属電極及びワイ ヤボンディング用パッドが、次の工程により形成される

ことを特徴とする。すなわち、(1)圧電体の基板上に 金属膜を被着させる工程と、(2)前記金属膜をフォト リソグラフィにより金属電極領域とワイヤボンディング 用パッドを形成する工程と、(3)前記ワイヤボンディ ング用パッドをレジストで被覆した後、エッチングによ り前記金属電極領域の金属膜の厚さを薄くして金属電極 とせしめる工程により形成される。

#### [0011]

【作用】本発明によれば、従来のように金属薄膜の被着 用パッドの膜厚を厚くすることができる。また、例えば 有機アルカリ系現像液を用いた方法でアルミニウムやそ の合金等の金属膜を容易にエッチングできるので、四ホ ウ酸リチウム (Li2B407) 単結晶のように酸に弱い材料 にも適用できる。これにより、金属膜の基板に対する密 着強度の低下に起因するワイヤボンディング不良をなく し、弾性表面波素子の製造歩留まりを向上させることが できる。さらに、リフトオフ法の採用により金属の蒸着 時に基板を高温に加熱できず金属膜の密着強度が低下し たとしても、ワイヤボンディング用パッドの膜厚を厚く することによりワイヤボンディング不良が起こらない。 [0012]

【実施例】本発明に係る一実施例を図面に基づき詳細に 説明する。図1(a)~(i)に示すように基板1上に 金属電極(本実施例では櫛形電極)の微細パターンを形 成する工程について説明する。まず、厚さ500 μm 程度 のLi2B407 単結晶の透明な基板 1 を用意し、これを純 水,アセトン等によって超音波洗浄を行い(図1

(a))、この基板1に対してノボラック系樹脂のレジ ストをスピンコート法により塗布して厚さ約1.5 μm の 単層のレジスト2を塗布形成する(図1(b))。

【0013】次に、レジスト2を所定形状の開口を有す るガラスマスク(厚み2~3 mm,5インチ角のソーダライ ムガラス上に膜厚約 0.86 μm のクロムでパターニング したもの)で被覆し、このガラスマスクの上方から波長 約405 nmの紫外光を照射し、しかる後に有機アルカリ系 現像液(例えば、TMAH;テトラメチルアンモニウム ハイドロオキサイド)を用いて現像することにより所定 形状のレジストパターン3を得る(図1(c))。

【0014】そして、レジストパターン3上に後工程で 40 除去するアルミニウム薄膜4cを、基板1上に櫛形電極 となるアルミニウム薄膜4 a, ワイヤボンディング用バ ッドとなるアルミニウム薄膜4bを、真空蒸着法により 厚さ約1.0 μm の単一層に被着形成し(図1(d))、 レジストパターン3をアセトン等により溶解して除去 し、櫛形電極及びワイヤボンディング用バッドとなるア ルミニウム薄膜4a, 4bを残して、レジスト3上に被 **覆されたアルミニウム薄膜4bを剥離する(図1** (e)),

【0015】さらに、基板1及び基板1上に形成された 50 合には有機アルカリ系現像液を用いてエッチングが可能

より厚さ約 1.5μm の単層のレジスト5a, 5b, 5c を塗布形成し(図1(f))、図1(c)で示した工程 と同様にして、レジスト5 a、5 b、5 cを所定パター ンを有するガラスマスクで被覆し、その上方から紫外光 を照射し、しかる後に上記した有機アルカリ系現像液で 現像を行い(図1(g))、ワイヤボンディング用パッ ド4b上のレジスト5bのみを残留させ、櫛形電極とな るアルミニウム薄膜4a上のレジスト5aや基板1上の

アルミニウム薄膜4 a 上にレジストをスピンコート法に

形成工程を余分に増やすことなく、ワイヤボンディング(10)レジスト5cを溶解除去した後に、アルミニウムがアル カリ溶液に可溶であることを利用して、櫛形電極となる アルミニウム薄膜4 a を設定膜厚 0.27 μm までエッチ ングし(図1(h))、最後にレジスト5bをアセトン により溶解して除去し、所望の微細な櫛形電極の金属電 極パターン4 d とワイヤボンディング用パッド4 bを有 する弾性表面波素子Sを作製することができるのである (図1(i))。

> 【0016】ここで、ワイヤボンディング用パッドと櫛 形電極との段差は、櫛形電極の厚み (0.5 μm 以上;0.5 より薄いと密着性が悪くなる) 及びワイヤボンディング 用パッドの厚み (1.0 ~1,5 μm 程度) を考慮すると0. 5 μm 以上必要であり、好ましくは0.5 ~1.0 μm とす

【0017】以上のように、ワイヤボンディング用パッ ドのみ膜厚を厚くした弾性表面波素子を作製することが でき、従来のように金属薄膜の被着形成工程を余分に増 やすことなく、ワイヤボンディング用パッドの膜厚を金 属電極より厚く形成することがきわめて容易に実現させ ることができ、しかも確実なワイヤボンディングを行わ 30 せることが可能となる。

【0018】本実施例では金属電極としてアルミニウム を用い、そのエッチング溶液として有機アルカリ系現像 液を用いた方法について説明したが、このエッチング溶 液に限定されるものではなく、例えば水酸化ナトリウム (NaOH)水溶液や水酸化カリウム(KOH) 水溶液等を用いる ことが可能である。また、金属電極としてアルミニウム 以外にアルミニウムを主成分とする合金、例えばチタン (Ti) や銅 (Cu)を含有したアルミニウム合金等ア ルカリ溶液に可溶なものであればよい。また、金属電極 も櫛形電極に限定されるものではなく周知の各種形状の 金属電極に適用することが可能であり、本発明の要旨を 逸脱しない範囲内で適宜変更し実施し得る。

## [0019]

【発明の効果】以上のように、本発明の弾性表面波素子 及びその製造方法によれば、従来のように金属膜の蒸着 工程を余分に増やすことなくワイヤボンディング用バッ ドの膜厚を厚くすることができ、きわめて簡便に信頼性 の高い弾性表面波素子の製造方法を提供することができ る。また、例えば金属電極膜の材料がアルミニウムの場

5

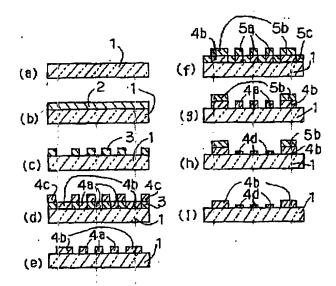
であり、特に Li2B407単結晶のように酸に弱い材料にも 十分に適用することができる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】 (a) ~ (i) は本発明に係る一実施例のリフトオフ工程を示す図である。

【図2】(a)~(i)は従来の弾性表面波素子の製造工程を示す図である。

【図1】



## 【符号の説明】

1 · · · 基板 2 · · · レジスト 4 b · · · · ワイヤボンディング用パッド 4 d · · · 企属電極パターン(櫛形電極) S · · · , 弾性表面波素子

# [図2]

